

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年5月11日(11.05.2018)



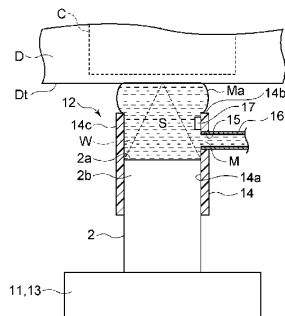
(10) 国際公開番号

WO 2018/083882 A1

- (51) 国際特許分類:
G01N 29/265 (2006.01) *G01R 31/26* (2014.01)
G01N 29/28 (2006.01) *G01R 31/28* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2017/032545
- (22) 国際出願日: 2017年9月8日(08.09.2017)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2016-216025 2016年11月4日(04.11.2016) JP
- (71) 出願人: 浜 松 ホ ト ニ ク ス 株 式 会 社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP];
〒4358558 静岡県浜松市東区市野町 1 1
2 6 番地の 1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者: 松 本 徹 (MATSUMOTO Toru);
〒4358558 静岡県浜松市東区市野町 1
1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株
式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki
et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二
丁目 1 番 1 号 丸の内 M Y P L A Z A
(明治安田生命ビル) 9 階 創英国際特
許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,

(54) Title: ULTRASONIC INSPECTION DEVICE

(54) 発明の名称: 超音波検査装置



(57) **Abstract:** An ultrasonic inspection device 1 for inspecting a packaged semiconductor device D, said ultrasonic inspection device 1 comprising: an ultrasonic transducer 2 that is disposed opposite to the semiconductor device D; a medium holding unit 12 that is provided to an end 2b of the ultrasonic transducer 2 opposite to the semiconductor device D, and holds a medium M through which ultrasonic waves W are propagated; a stage 3 that moves the relative positions of the semiconductor device D and the ultrasonic transducer 2; and an analysis unit 22 that analyzes the reaction of the semiconductor device D in response to input of the ultrasonic waves W from the ultrasonic transducer 2.

(57) 要約: 超音波検査装置 1 は、パッケージ化された半導体デバイス D を検査対象とする装置であって、半導体デバイス D に対向して配置される超音波振動子 2 と、超音波振動子 2 において半導体デバイス D に対向する端部 2 b に設けられ、超音波 W を伝搬させる媒質 M を保持する媒質保持部 1 2 と、半導体デバイス D と超音波振動子 2 との相対位置を移動させるステージ 3 と、超音波振動子 2 による超音波 W の入力に応じた半導体デバイス D の反応を解析する解析部 2 2 と、を備える。

[続葉有]

WO 2018/083882 A1

ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）